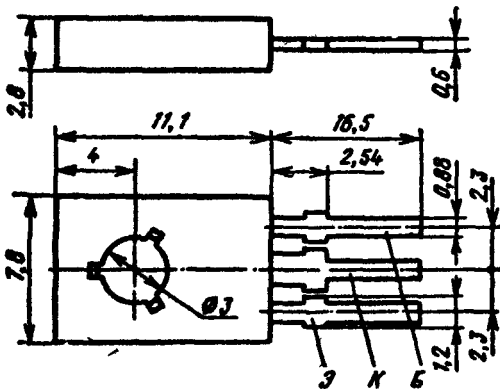


КТ814 (А, Б, В, Г)

КТ814 (А-Г)



Транзисторы кремниевые меза-эпитаксиально планарные структуры *p-n-p* усилительные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях, импульсных устройствах. Корпус пластмассовый с жесткими выводами

Масса транзистора не более 1 г

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кБ} = 2$ В, $I_{в} = 0,15$ А, не менее:

КТ814А, КТ814Б, КТ814В	40
КТ814Г	30

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кБ} = 5$ В, $I_{в} = 30$ мА, не менее

3 МГц

Граничное напряжение при $I_{в} = 50$ мА, не менее

КТ814А	25 В
КТ814Б	40 В
КТ814В	60 В
КТ814Г	80 В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_{к} = 0,5$ А, $I_{в} = 0,05$ А, не более

0,6 В

Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_{к} = 0,5$ А, $I_{в} = 0,05$ А, не более

1,2 В

Обратный ток коллектора при $U_{кБ} = 40$ В, не более:

$T_{к} = -40 \dots +25$ °С	50 мкА
$T_{к} = +100$ °С	1 мА

Емкость коллекторного перехода при $U_{кБ} = 5$ В, $f = 465$ кГц, не более

60 пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{вБ} = 0,5$ В, $f = 465$ кГц, не более

75 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер:

при $R_{св} = \infty$:

КТ814А	25 В
КТ814Б	40 В
КТ814В	60 В
КТ814Г	80 В

при $R_{св} \leq 100$ Ом.

КТ814А	40 В
КТ814Б	50 В
КТ814В	70 В
КТ814Г	100 В

Постоянное напряжение эмиттер — база

5 В

Постоянный ток коллектора

1,5 А

Импульсный ток коллектора при $t_{и} \leq 10$ мс, $Q \geq 100$

3 А

Постоянный ток базы

0,5 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора¹ при $T_{к} =$

$-40 \dots +25$ °С

с теплоотводом 10 Вт

без теплоотвода 1 Вт

Температура *p-n* перехода +125 °С

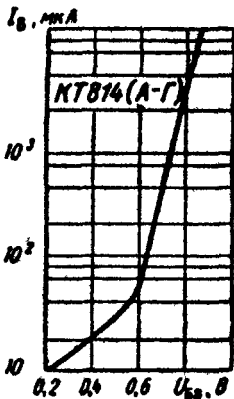
Температура окружающей среды -40 °С.. $T_{к} =$

+100 °С

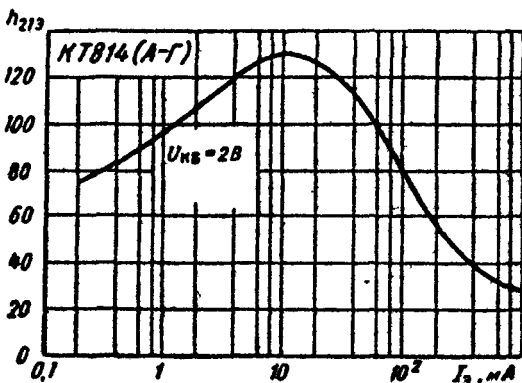
¹ При $T_{к} = +25 \dots +100$ °С $P_{к, макс}$ снижается линейно на 0,01 Вт/°С без теплоотвода и на 0,1 Вт/°С с теплоотводом.

Изгиб выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5..2 мм. При этом должны приниматься меры, исключающие возможность передачи усилий на корпус. Изгиб в плоскости выводов не допускается.

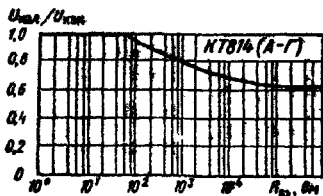
Пайка выводов транзисторов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса. При пайке жало паяльника должно быть заземлено.



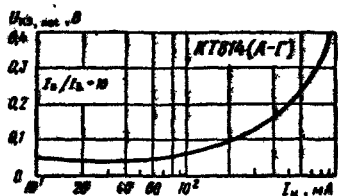
Входная характеристика



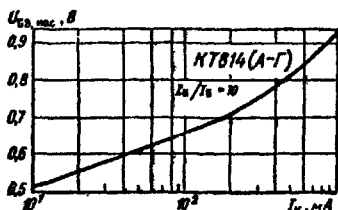
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



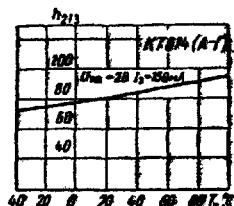
Зависимость постоянного напряжения коллектор — эмиттер от сопротивления база — эмиттер



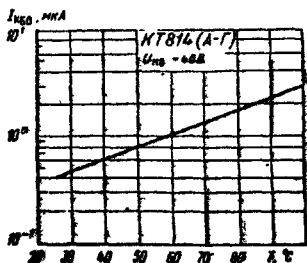
Зависимость напряжения насыщения коллектор — эмиттер от тока коллектора



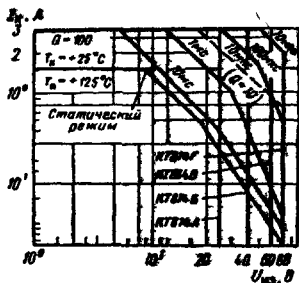
Зависимость напряжения насыщения база — эмиттер от тока коллектора



Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры корпуса



Зависимость обратного тока коллектора от температуры



Области максимальных режимов